FLUORESCENT SCREEN

Patent Application number:

JP61-283681

Publication date: 1986-12-13

Inventor:

SCHUTTEN EVERT DIEKS; VERLIJS DONK, JOHANNES GODEFRIDU

Applicant:

PHILIPS NV

Classification:

- international:

C09K11/59;

C09K11/64;

H01J61/44

- european:

C09K11/475D

Application number: JP19860125948 19860602 Priority number(s): NL19850001599 19850604

Abstract not available for JP61-283681

Abstract of corresponding document: US4716335

A luminescent screen provided with a terbium-activated silicate having a cuspidine crystal structure according to the formula Y4-x-z-pCaxMzIITbpSi2-yAlyO7+x+z+yN2-x-z-y. In this formula MII is at least one of the elements Mg, Sr and Ba. The yttrium can be replaced up to at most 50 mol. % by Gd and/or La. It further holds that: 0</=x</=1.9 0</=z</=1.0o</=y</=1.9 x+z+y</=1.9 0.05</=p</=1.5.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-283681

段発明の名称 けい光スクリーン

②特 願 昭61-125948

②出 願 昭61(1986)6月2日

優先権主張 - 201985年6月4日 (NL) (NL) (198501599

79発 明 者 エヴアート・ディーク オラング国ローゼンダール ツヴアーンホフ ストラート

ス・シュツテン

⑦発 明 者 ヨハネス・ホデフリド オランダ国 5621 ベーアー アインドーフェン フルー

ウス・フェルリエイス ネヴアウツウエツハ1

ドンク

⑪出 願 人 エヌ・ベー・フィリツ オラング国5621 ベーアー アインドーフェン フルーネ

プス・フルーイランペ ヴアウツウエツハ1

ンフアブリケン

现代 理 人 弁理士 杉村 暁秀 外1名

明 細 杳

1. 発明の名称 けい光スクリーン

2. 特許請求の範囲

支持体上に施され且つカスピダイン結晶構造を有するテルビウム付活けい光珪酸塩より成るけい光層をそなえたけい光スクリーンにおいて、珪酸塩は構造式

Y_{4-x-z-p}CaxM[®]Tb,Si_{2-y}Al_yO_{7+x+s+x}N_{2-x-s-y}に相当し、この場合M[™]は元素Mg、SrおよびBa の少なくとも1つを表わし、イツトリウムは 元素GdおよびLaの少なくとも1つで最大50モルX まで置換されることができ、また

 $0 \le x \le 1.9$

 $0 \le z \le 1.0$

 $0 \le y \le 1.9$

 $x + z + y \le 1.9$

 $0.05 \le p \le 1.5$

であることを特徴とするけい光スクリーン。

2. 珪酸塩は構造式

Y_{4-x-p}Ca_x Tb_p Si₂O_{7-x} N_{2-x}に相当し、この

場合0.5 ≤x ≤1.5 である特許請求の範囲第 1項記載のけい光スクリーン。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、支持体上に施され且つカスピダイン (caspidine) 結晶構造を有するテルビウム付活けい光珪酸塩より成るけい光層をそなえたけい光スクリーンに関するものである。

「フィリップス・リサーチ・リポーツ (Philips Res. Repts.)1967 年、22、第481 ~504 頁の記載から、その基本格子が構造式Y.2Ca.2Si.2O.に相当するテルピウム付活けい光珪酸塩は知られている。この珪酸塩ならびにやはりテルピウム付活について記載されている同形化合物 (isomorphous compound) Y.Al.2O.も鉱物カスピダイン (Ca.Si.2O.F.2)

の単斜晶系結晶構造を有する。更にY₂SiO₅ およびY₂Si₂O₇ のタイプの基本格子を有するテルピウム付活建酸塩も例えば米国特許明細音第3523091号および3758413 号より知られている。

テルピウム元素は、多くの結晶格子に極めて効 率のよいけい光を生じ、固有の緑色Tb^{3・}放射線が

放射されるので、屢々用いられるけい光材料用付 括剤である。けれども、紫外線による励起に際し ては、けい光材料をその材料の励起スペクトルの。 極大またはこの極大に極めて近い波長の放射線で 励起することが効率的なけい光を得る1つの条件 である。このような材料の重要な用途は、低圧水 **銀蒸気放電ランプに見出される。この種のランプ** では、約254nm の波長の紫外線が主として発生さ れる。多くのテルピウム付活剤の大きな欠点は、 テルピウムの励起帯域の極大が254nm から比較的 離れたところにある波長に見出されるということ である。この場合には、励起エネルギが先づ別の 付活剤に吸収され、これによってこのエネルギが チルビウムに移された場合にのみ効率的なけい光 を得ることができる。この吸収と移行の間に云う 迄もなく損失が生じ得る。

本発明は、テルビウムで付活され、実際的な用途においてテルビウム内で直接に励起されることのできる新しいけい光材料より成るけい光スクリーンを得ることを目的とするものである。

が見出されている。けれども、テルピウムで付活すると、これ等の化合物は実際の用途に対して量子収量が小さ過ぎる。したがって、本発明のけい光珪酸塩ではイットリウムが用いられ、このイットリウムは、Gdおよび/またはLaにより最大で50モル% 置換することができる。このような置換は珪酸塩の結晶構造に影響を与えず、けい光特性にも実質上影響がない。

Y.Si₂O,N₂ 格子では、イットリウムは更に一部をCaおよびM で表わされる元素Mg. Sr およびBaで 置換されることができ、一方更にSiは一部をAIで 置換されることができる。CaおよびAIでの置換に おいてカスピダイン構造は維持される。MI元素で の置換は、このMIの量が多過ぎると好ましくない 二次相(secondary phase) が形成されるので、 或 る限られた範囲内だけで可能である。したがって この珪酸塩では最大で25モルM のイットリウムが M で置換される (Z ≤1.0)。Ca、 MI および/ま たはAIでの置換においては、電荷補債 (charge compensation) を得るために、Nの同じモル量を 本発明は、冒頭に記載した種類のけい光スクリーンにおいて、珪酸塩が構造式

Y. -x-z-PCax Mx Tbp Siz-y Aly OT-H-Z-Y

 $N_{2-x-z-y}$ に相当し、この場合 N^{2} は元素 M_{2} 、Sr およびBaの少なくとも1つを表わし、イットリウムは元素Gd およびLaの少なくとも1つで最大S0 モル% まで置換することができ、また

 $0 \le x \le 1.9$

 $0 \le z \le 1.0$

 $0 \le y \le 1.9$

 $x + z + y \le 1.9$

 $0.05 \le p \le 1.5$

であることを特徴とするものである。

格子Y、Si₂O₁N₂をベースとする窒素含有珪酸塩は、テルビウムによる付活によって模めて効率的なけい光材料を形成することが見出された。 Y、SiO₂O₁N₂はカスピダイン結晶構造を有し、それ自体は公知のものである。

カスピダイン構造を有する対応した化合物 Gd、SiO₇N。 およびLa、SiO₇N。 もまた得られること

0で関換せねばならない。化合物Y、Si2Q、N2と酸素のみ含有するY2Ca2Si2Q。およびY、Al2Q。との間に窒素含有量が減少してゆく連続的な一連の化合物が可能であることが見出された。窒素含有珪酸塩とは、テルビウムで付活されると異なる励起スペクトルを有することが見出された。大きな利点は、NとOの比を適当に選ぶことによって励起スペクトルの極大の位置を或る限度内で所定の用途に望まれる値に適合させることができるということである。

前迩の一般構造式と本発明のけい光スクリーンのけい光珪酸塩に対する条件から、Y。の最大で1.9 モルがCaで置換され $(x \le 1.9)$ またSiの最大で1.9 モルがAIで置換され $(y \le 1.9)$ ることがわかる。Ca (および場合によってはIII) によるYの置換とAIによるSiの置換が同時に行われる場合には、これ等の置換全体がやはり最大でI.9 になる($x+z+y\le I.9$)。実際に、けい光珪酸塩が最少量の窒素(珪酸塩のモル当りN0.1 モル)を有することが重要である。テルビウムの含有量Pは

少なくとも0.05である。というのはpの値がそれよりも少なければ励起放射線の吸収が小さ過ぎるため、得られる光東が余りに小さいからである。このテルビウム含有量は最大でも1.5 である、というのは、それよりも大きな値では適度消失(concentration quenching)のために、得られる光東が小さ過ぎるからである。

本発明のけい光スクリーンでは、構造式が
Y_{1-x-x}Cax Tb, Si₂O_{7-x} N_{2-x}でこの場合 x は0.5
≤x ≤1.5 である珪酸塩を用いるのが好ましい。
実際に、最も大きな光束は、特に254nm の放射線での励起に降し、μ¹ もAlも含まないカルシウム所は での配置 換ることがわかった。 可能関係でののでは次のような結果を生じる。 すなわち、より高い量子でのは、への励いることが得られる。 したが銀気放電ランプに見出される。

けい光珪酸塩は、成分元素の酸化物または温度

上昇によってこれ等酸化物を生じる化合物から形成された出発原料の混合物の高温での固相反応によって得ることができる。おもに窒素がSioNにとして混合物に加えられ、この場合一般に過剰の変素が用いられる。固相反応(solid state reaction)を助成するために、僅かに余分の珪素例えば2~3モルドの珪素を使用してもよい。混合物は次いで弱い避元よん囲気中で1200で~1700での温度で一回または数回加熱され、かくしてけい光珪酸塩が形成される。

以下に本発明のけい光スクリーンに適したけい 光珪酸塩の実施例を図面、製法例および多数の例 定結果を参照して更に詳しく説明する。

第1図は管状ガラス壁1を有する低圧水銀蒸気 放電ランプの断面図を線図的に示す。このランプ の両端には電極2および3が配設され、この電極 の間に動作中放電が維持される。このランプには、 少量の水銀と始動ガスとしての稀ガスが入れられ る。壁1はけい光スクリーンの支持体を形成し、 内面には、本発明のけい光珪酸塩より成るけい光

層 4 が設けられる。このけい光層 4 は、通常の方 法例えばけい光珪酸塩を有するサスペンションに よって壁 1 に施すことができる。

例 1

混合物は

- 7.598g @ 1203
- 0.662g @Tb.07
- 0.426g ØSi02
- 1. 368g OSi a Na

よりつくられた。この混合物はモリブデンのるつは内で1350 セで 1 時間密閉炉で加熱され、この炉を経て容積で 5 %の水器を含む窒素流(6 ℓ/min)が通された。冷却および微粉砕の後、得られた製品は同じふん囲気内で再び1500 セで 2 時間加熱された。冷却および均質化の後、Y_{2,1} *Tbo.₂ Si₂O,N₂の構造式のテルピウム付活珪酸塩が得られた。 X線回折分析の結果、この珪酸塩は(本発明のけい光珪酸塩の以下のすべての例と同様に)カスピダイン結晶構造を有することが明らかにされた。短波長の紫外線(主として254nm)で励起されると、

この珪酸塩はTb³⁺の固有の緑色の線放射線(line emission) を示した。この珪酸塩は55% の量子収量を有し、一方254nm 励起放射線の吸収は88% になった。

例 2-7

前記の例1に記載されたと間様にして、異なる組成の多数のテルピウム付活珪酸塩がつくられた。これ等珪酸塩の構造式と254nm 放射線での励起による量子収量(%で示した06) およびこの励起放射線の吸収(%で示したA)の測定結果とを次の表に示す。

例	構 造 式		A	30
1	Ya. aTbo. aSi aO7N2	1)	88	55
2	Ya. eTbo Si 207N2	2)	91	64
3	Ya. aTbo. aSiA10.N		92	48
4	Ya. 3Cao. 5Tbo. 2Si 2D7. 5N1. 6	1)	85	62
5	Y1. eCaTbo. 2Si2OeN	1)	80	72
6	Y2. 55 Ca 1. 25 Tbq. 25 120 e. 25 No. 75		79	77
7	Y2. 3Ca1. 5Tbo. 2Si 20e. 5No. 5		80	74

- (本発明によるものではないが)Y_{1. 4}Ca₂Tb_{0.2}
 (本発明によるものではないが)Y_{1. 4}Ca₂Tb_{0.2}
 の励起スペクトルの極大は夫々263,259,255
 および235nm において見出された。
- 2) この珪酸塩の放射線のスペクトルエネルギ分布(254nm 励起における) を第2 図に示す。この図では、nmで表わした波長は機軸に、任意の単位の相対放射線の強さEは凝線にとってある。この珪酸塩は55% の量子収量を有し、一方254nm 励起放射線の吸収は88%になった。
- 4. 図面の簡単な説明

第 i 図は本発明のけい光スクリーンをそなえた 低圧水銀蒸気放電ランプの断面図

第2図はテルビウム付活建酸塩の放射線のスペクトルエネルギ分布図である。

ⅰ…管状ガラス壁

2.3 …電極

4 …けい光層

